

大学物理 B 静电场作业

1. 关于场的叠加原理的理解, 下列说法中错误的是: [B]

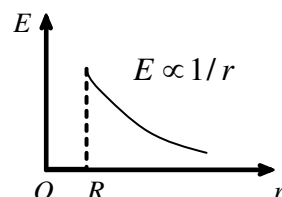
- (A) 两种性质相同的场可以占据同一个空间.
- (B) 两种性质不相同的场不可以占据同一个空间.
- (C) 矢量场在叠加时服从平行四边形法则.
- (D) 场经过叠加后, 仍然能保持自身原有的性质.

2. 关于高斯定理, 下列说法中哪一个是正确的? [C]

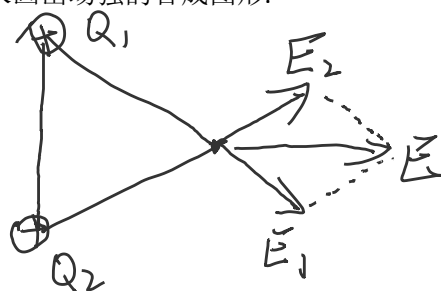
- (A) 若高斯面内无电荷, 则高斯面上各点的场强处处为零.
- (B) 若高斯面上场强处处为零, 则高斯面内必不存在电荷.
- (C) 高斯面上的电场强度通量仅与高斯面内电荷的代数和有关.
- (D) 以上说法都不正确.

3. 真空中, 静电场的环路定理的数学表达式是 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$, 它说明静电场是保守场, 静电场力是保守力, 电场线具有不相交, 不闭合特点.

4. 图中曲线表示一种轴对称性电荷分布产生的电场分布, r 表示离对称轴的距离. 这是由均匀带电球面产生的电场强度分布曲线.



5. 在边长为 a 的正三角形二个顶点上各放一个带正电的点电荷 Q , 求未放电荷的那个顶点上的场强和电势, 要求画出场强的合成图形.



$$E_1 = E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{a^2}$$

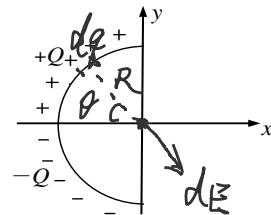
$$E_{1\perp} = E_{2\perp} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{a^2} \cos \frac{\pi}{3}$$

$$E_{1\parallel} = E_{2\parallel} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{a^2} \cos \frac{\pi}{6}$$

$E_{1\perp}$ 与 $E_{2\perp}$ 等大反向相抵消

$$\begin{aligned} E &= E_{1\parallel} + E_{2\parallel} = 2 \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{a^2} \cos \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{\sqrt{3}Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \end{aligned}$$

6. 如右图所示，一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形，沿其上半部分均匀分布有电荷 $+Q$ ，沿其下半部分均匀分布有电荷 $-Q$ ，如图所示：试求：

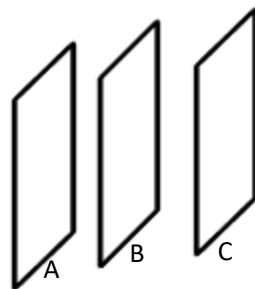


(1) 圆心 O 处的场强； (2) 圆心 O 处的电势。

解：(1) 在上半部分取线元 dl ，距 x 轴为 x ，电荷 dq 与其关于 x 轴对称都会有一个线元 dl ，电荷 $-dq$ 。 dq 在点 O ，产生的电场强度 dE 的方向如图所示，大小为 $dE = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ 。 dE 在 y 轴上的分量 $dE_y = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta$ 。 dE 在 x 轴上的分量 $dE_x = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sin\theta$ 。因为下半部分与 dq 对称的 $-dq$ 在 x 轴上的分量与 dq 的等大反向抵消，所以 O 点的总电场强度一定沿 y 轴。
$$E = \int dE_y = 2 \int \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta = 2 \int \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta$$
$$= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \int_0^{\pi/2} \cos\theta d\theta$$
$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \cdot \sin\theta \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

(2) O 点场强 $U = U_+ + U_-$
$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$
$$= \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0 R}$$

7. 有三个无限大均匀带电平面A、B、C平行放置，如图：其带电面密度分别为 $\sigma_A = 3 \times 10^{-6}$ 、 $\sigma_B = -6 \times 10^{-6}$ 、 $\sigma_C = -2 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ ，求：



(1) AB间的场强；

(2) BC间的场强。

解：平面A的场强 $E_A = \frac{\sigma_A}{2\epsilon_0}$

平面B的场强 $E_B = \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0}$

平面C的场强 $E_C = \frac{\sigma_C}{2\epsilon_0}$

(1) 根据场强叠加原理AB间的场强

$$\begin{aligned} \text{大小 } |E_{AB}| &= |E_A - E_B - E_C| = \left| \frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_C}{2\epsilon_0} \right| \\ &= \left| \frac{3 \times 10^{-6} + 6 \times 10^{-6} + 2 \times 10^{-6}}{2 \times 8.85 \times 10^{-12}} \right| = 6.2 \times 10^5 \text{ C/N 方向水平向右} \end{aligned}$$

(2) 根据场强叠加原理BC间的场强

$$\begin{aligned} \text{大小 } |E_{BC}| &= |E_A + E_B - E_C| = \left| \frac{\sigma_A}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_B}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_C}{2\epsilon_0} \right| \\ &= \left| \frac{3 \times 10^{-6} - 6 \times 10^{-6} + 2 \times 10^{-6}}{2 \times 8.85 \times 10^{-12}} \right| = 5.6 \times 10^4 \text{ C/N 方向水平向左} \end{aligned}$$

8. 真空中，有一内、外半径分别为 R_1 、 R_2 的带电球壳，其电荷体密度分布为：

$\rho = k/r$ ($R_1 < r < R_2$)， $\rho = 0$ ($R_1 > r$ 或 $r > R_2$)， k 为常量。求：

(1) 球壳内的场强；(2) 球壳中的场强；(3) 球壳外的场强。

解：以一个半径为 r 的球面为高斯面 $\Phi_e = E d\vec{s} \cdot \vec{s} = E \cdot 4\pi r^2$ ①

(1) 当 $r < R_1$ 时，由高斯定理可知 $\Phi_e = 0$

得 $E = 0$ ，所以球壳内的场强为0

(2) 当 $R_1 < r < R_2$ 时，由高斯定理可知

$$\Phi_e = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} = \frac{\int_V \rho dV}{\epsilon_0} = \frac{\int_{R_1}^r \frac{k}{r} \cdot 4\pi r^2 dr}{\epsilon_0} = \frac{\int_{R_1}^r 4\pi k r dr}{\epsilon_0} = \frac{2\pi k (r^2 - R_1^2)}{\epsilon_0} \quad ②$$

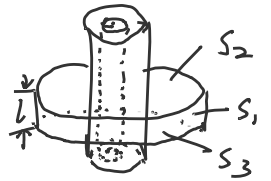
联立①②得 $E = \frac{k(r^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0 r^2}$ ，所以球壳中的场强为 $\frac{k(r^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0 r^2}$

(3) 当 $r > R_2$ 时，由高斯定理可知 $\Phi_e = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} = \frac{\int_{R_1}^{R_2} 4\pi k r dr}{\epsilon_0} = \frac{2\pi k (R_2^2 - R_1^2)}{\epsilon_0}$ ③

联立①③得 $E = \frac{k(R_2^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0 r^2}$ 所以在球壳外的场强为 $\frac{k(R_2^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0 r^2}$

9. 真空中, 有无限长带电柱壳, 设该柱壳的电荷体密度为 ρ , 介电常数为 ϵ_0 , 其内、外表面的半径分别为 R_1 、 R_2 , 求该柱壳的电场分布.

以 r 为底面半径, 高为 l 的圆柱面为高斯面



$$\begin{aligned} \Phi_e &= \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \oint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\pi r l E \quad (1) \end{aligned}$$

当 $r < R_1$ 时, 由高斯定理可知 $\Phi_e = 0$ (2), 联立 (1) (2) 得 $E = 0$
 当 $R_1 < r < R_2$ 时, 由高斯定理可知

$$\Phi_e = \frac{\sum q}{\epsilon_0} = \frac{\int_V \rho dV}{\epsilon_0} = \frac{\rho \int_{R_1}^r 2\pi r l dr}{\epsilon_0} = \frac{\pi \rho l (r^2 - R_1^2)}{\epsilon_0} \quad (3)$$

联立 (1) (3) 得 $E = \frac{\rho(r^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0 r}$

当 $r > R_2$ 时, 由高斯定理可知

$$\Phi_e = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} = \frac{\int_V \rho dV}{\epsilon_0} = \frac{\rho \int_{R_1}^{R_2} 2\pi r l dr}{\epsilon_0} = \frac{\pi \rho l (R_2^2 - R_1^2)}{\epsilon_0} \quad (4)$$

联立 (1) (4) 得 $E = \frac{\rho(R_2^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0 r}$

综上所述, $E = \begin{cases} 0, & r < R_1 \\ \frac{\rho(r^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0 r}, & R_1 < r < R_2 \\ \frac{\rho(R_2^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0 r}, & r > R_2 \end{cases}$